**Тимошнев, Сергей Николаевич. Электронная структура границ раздела Cs/InGaN, Cs/GaN, Ba/GaN, Ba/AlGaN и формирование аккумуляционного слоя : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Тимошнев Сергей Николаевич; [Место защиты: С.-Петерб. Академический ун-т - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН].- Санкт-Петербург, 2011.- 148 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/1199**